

تأثیر دمای آنیل بر خواص ساختاری و مغناطیسی لایه نازک نئودمیوم آهن بور

علیرضا خانجانی^{*}، علی قاسمی و مرتضی هادی

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان

(دربافت مقاله: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ - دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۱۵)

چکیده – در این پژوهش لایه‌های نازک نئودمیوم آهن بور با لایه بافر و لایه محافظ تنگستن بر زیرلایه Si/SiO_2 به روش پراکنش امواج رادیویی مگنترونی تولید شد. سپسistem ایجاد شده در دماهای ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۵۰، ۶۰۰ و ۶۵۰ سانتی‌گراد در خلاء تحت عملیات بلوری شدن قرار گرفت. آنالیز فازی لایه‌ها توسط پراش پرتو ایکس پرسی شد و وجود فاز $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ بدون هیچ نوع فاز ثانویه دیگری تایید شد. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی سطح مقطع پوشش و دانه‌بندی لایه‌ها به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت. ریخت سطح لایه‌ها توسط میکروسکوپ نیروی اتمی بررسی شد. خواص مغناطیسی لایه شامل نیروی پسماندزد، مغناطش اشباع و سطح حلقه پسماند توسط مغناطومتر ارتعاشی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که با آنیل در دمای ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد، ساختار لایه غیربلورین است. با افزایش دمای آنیل به ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد بالاترین شدت قله به دست می‌آید و با افزایش بیشتر شدت کاهش می‌یابد. با افزایش دمای آنیل اندازه دانه افزایش می‌یابد که بر میزان نیروی پسماندزدا موثر است. با افزایش دمای آنیل به ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد نیروی پسماندزدا عمودی افزایش می‌یابد و با ازدیاد بیشتر دمای آنیل مقدار این متغیر به علت افزایش بیش از حد اندازه دانه‌ها کاهش می‌یابد. با توجه به خواص مغناطیسی و ساختاری لایه‌ها می‌توان نتیجه گرفت که لایه آنیل شده در دمای ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد دارای دلخواه‌ترین خواص مغناطیسی و ساختاری است.

واژگان کلیدی: لایه نازک، نئودمیوم آهن بور، نیروی پسماندزدا

The Role of Annealing Temperature on Structural and Magnetic Properties of NdFeB Thin Films

A. Khanjani^{*}, A. Ghasemi and M. Hadi

Department of Materials Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Iran

Abstract: In the present research NdFeB thin films coupled with buffer and capping layer of W were formed on Si/SiO_2 substrate by means of RF magnetron sputtering. The system was annealed at vacuum at different temperatures of 450, 500, 550,

* مسئول مکاتبات پست الکترونیکی: alikhajani@yahoo.com

600 and 650 °C Phase analysis was carried out by XRD and it was found that NdFeB was formed without the formation of any kind of secondary phase. The cross sectional and grain size of the thin films were measured by scanning electron microscopy. Morphological studies were performed by atomic force microscopy. Magnetic properties of thin films including coercivity, saturation of magnetization and hysteresis area were evaluated by vibrating sample magnetometer. It was found that by annealing at 400 °C the amorphous layer was formed. The highest intensity of peaks was formed at 550 °C and with an increase in temperature the intensity was declined. The grain size was increased by temperature and had an impact on the coercivity. With an increase of temperature up to 600 °C, perpendicular coercivity was increased and then by further increase of temperature, coercivity was reduced. Based on the obtained data the temperature of 600 °C was selected as the optimum annealing temperature for reaching enhanced structural and magnetic feature.

Keywords: Thin film, NdFeB, Coercivity

نازک نئودمیوم آهن بور مقاومت به خوردگی ضعیف آن است.

با اعمال لایه دوگانه AlN/SiC به عنوان لایه محافظ می‌توان سرعت خوردگی یکنواخت را کاهش داد و مدت زمان بیشتری بردار مغناطش در سیستم ناهمسان‌گرد مغناطیسی پایدار بماند [۱۶]. دسته دیگری از پژوهش‌های مرز دانشی در این حوزه به بررسی‌های نحوه تشکیل حوزه‌های مغناطیسی توسط شبیه‌سازی پرداخته است. در این گونه از پژوهش‌ها تلاش می‌شود تا شرایط بهینه برای تشکیل آرایه‌های نقطه‌ای از فاز نئودمیوم آهن بور معین شود [۱۷].

پایداری گرمایی بردارهای مغناطش که بدليل تقابل انرژی ناهمسان‌گردی مغناطوبولوئی با انرژی گرمایی است نیز توسط سایر پژوهشگران بررسی شده است [۱۸]. پایداری گرمایی معین می‌کند که سوئیچینگ بردارهای مغناطش با گذشت دما و زمان با چه مکانیزمی رخ می‌دهد.

در پژوهش حاضر تلاش شد که ابتدا لایه نازک تنگستن به علت تطابق بلوری مناسب با نئودمیوم آهن بور به زیرلایه سیلیکون پوشش‌دهی شود. سپس لایه نازک مغناطیسی در دماهای مختلف پوشش‌دهی شد. دانه‌بندی لایه نازک به همراه تغییرات زبری سطح و رفتار مغناطیسی لایه‌ها به دقت مورد مطالعه قرار گرفت. ارتباط بین ویژگی‌های ساختاری با خواص مغناطیسی لایه‌ها مشخص شد و دمای بهینه برای رشد تک‌فاز نئودمیوم آهن بور توسط روش پراکنش با امواج رادیویی معرفی شد.

۱- مقدمه

در سال‌های اخیر، پژوهش‌های گسترش‌های در زمینه بهینه‌سازی لایه‌های نازک که در حافظه‌های مغناطیسی با چگالی ذخیره اطلاعات بسیار بالا کاربرد دارند، انجام شده است [۱، ۲]. لایه‌های نازک مغناطیسی سخت معمولاً از جنس PrFeB، NdFeB، GdFeCo، TbFeCo، Sm₂Co₁₇، SmCo₅ انتخاب می‌شوند، که شامل یک عنصر نادر خاکی دو یا سه طرفیتی در اوربیتال 4f و یک فلز انتقالی 3d با ناهمسان‌گردی مغناطوبولوئی بالا است [۱]. این عناصر پس از عملیات حرارتی مناسب به صورت نیترید، بوراید و یا ترکیبات بین فلزی در ترکیب ظاهر می‌شوند. آلیاژ Nd₂Fe₁₄B به عنوان یکی از مواد مغناطیسی سخت در حافظه‌های مغناطیسی، موتورهای الکترومغناطیسی، محرک‌ها و سنسورها کاربرد گسترش‌های دارد [۳-۶]. فاز Nd₂Fe₁₄B با ساختار تراگونال دارای ناهمسان‌گردی مغناطیسی تک محوری و مغناطش اشباع بالا است [۷] (Bs=1/6T).

تاکنون پژوهش‌های به نسبت وسیعی در مورد تهیه لایه نازک NdFeB صورت گرفته است. در اکثر این پژوهش‌ها هدف اصلی تشکیل فاز Nd₂Fe₁₄B با دانه‌بندی و ضخامت مناسب برای افزایش نیروی پسماندزدا و مغناطش اشباع است [۸-۱۴]. اخیراً لایه نازک نئودمیوم آهن بور توسط روش رسوب‌دهی پالسی لیزر تهیه شده است و حضور گاز نیتروژن در حین فرایند رشد لایه باعث ریزش دانه‌بندی و افزایش نیروی پسماندزدا و مغناطش اشباع شده است ولی مقاومت به خوردگی آلیاژ کاهش یافته است [۱۵]. مشکل استفاده از لایه

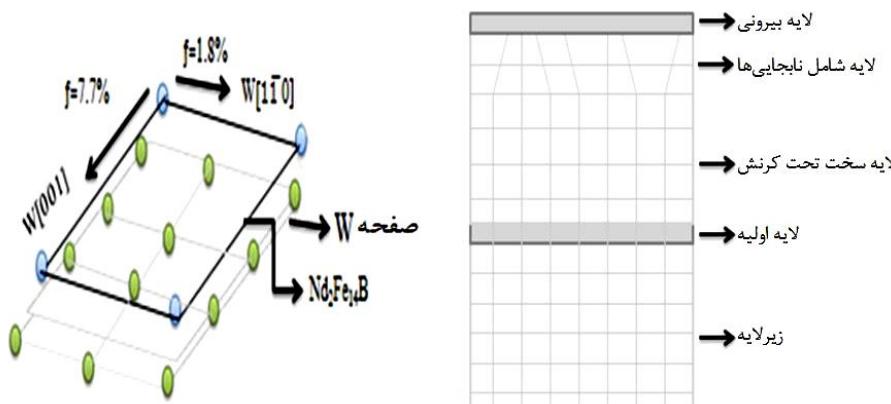
۳- نتایج و بحث

در این پژوهش از لایه بافر تنگستن بهمنظور جلوگیری از نفوذ اکسیژن موجود در زیرلایه به لایه مغناطیسی نئودمیوم آهن بور استفاده شد. همچنین لازم است که تطابق بلوری بین لایه مغناطیسی و لایه بافر ایجاد شود تا رشد لایه مغناطیسی با ناهمسانگردی مغناطیبلوری انجام شود. شکل ۱ ارتباط کریستالوگرافی بین لایه بافر تنگستن و لایه مغناطیسی نئودمیوم آهن بور را نشان می‌دهد. مشخص است که متغیر عدم انتباط در جهت [۱۱۰] و در صفحه (۱۱۰) تنگستن در حدود ۱/۸٪ است. میزان این متغیر در جهت [۱۱۰] تنگستن کمی بیشتر و در حدود ۷/۷٪ است. در این مورد بلوریت‌های Nd₂Fe₁₄B با صفحه (۰۰۱) می‌توانند بر صفحه (۱۱۰) تنگستن با متغیر عدم انتباط کمتر از ۹٪ رشد کنند. در شبکه Nd₂Fe₁₄B برای تطابق بلوری مناسب با اتم‌های صفحه (۱۱۰) لایه بافر تنگستن، کرنش الاستیکی ایجاد می‌شود. با توجه به شکل مشخص است که رشد کوهیرنت صفحه (۰۰۱) فاز تراگونال Nd₂Fe₁₄B بر صفحه (۱۱۰) تنگستن (bcc) امکان‌پذیر است و ماکریزم عدم انتباط دو صفحه برابر با ۷/۷٪ است که مقدار بسیار کمی است. با توجه به کوچک بودن فاکتور عدم تطابق بلوری بین لایه بافر و لایه مغناطیسی و همچنین کنترل میزان اکسیداسیون عنصر نئودمیوم در ترکیب مغناطیسی، استفاده از لایه بافر و لایه محافظ از جنس تنگستن بسیار لازم است.

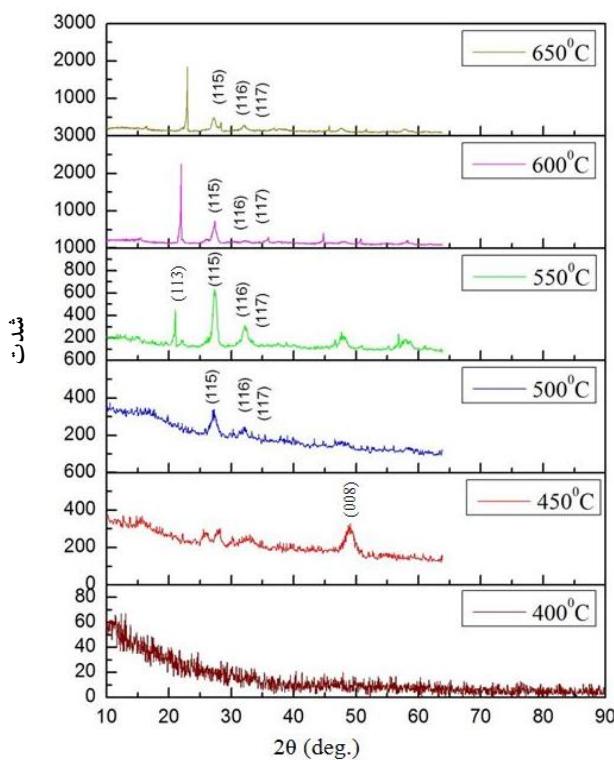
شکل ۲ الگوهای پراش پرتو ایکس از لایه نازک NdFeB آنیل شده در دماهای مختلف را نشان می‌دهد. تحلیل الگوهای به‌دست آمده نشان می‌دهد که قله‌های موجود تطابق کاملی با فاز Nd₂Fe₁₄B دارند. عدم حضور فازهای ثانویه که در تشکیل نئودمیوم آهن بور بسیار محتمل است، نشان‌دهنده مناسب بودن متغیرهای فرایند در سیستم لایه‌نشانی مگترون است. با توجه به ضخامت بسیار کم لایه تنگستن (۳ نانومتر) و دقیق روش پراش پرتو ایکس که فازهای کمتر از ۵٪ را آشکار نمی‌کند، هیچ قله‌ای از این عنصر در الگوی پراش مشاهده نمی‌شود.

۲- مواد و روش پژوهش

در این پژوهش، لایه‌های نازک به‌وسیله روش پراکنش امواج رادیویی مگترونی و با استفاده از هدفی با ترکیب Nd₂Fe₁₄B در دمای اتاق انجام شد. قبل از شروع عملیات پراکنش، برای پایدار ماندن پلاسماء، به مدت ۲۰ دقیقه عملیات پراکنش اولیه انجام شد. سپس بر روی زیرلایه Si/SiO₂ به ترتیب لایه‌های بافر تنگستن (ضخامت ۳ نانومتر)/لایه مغناطیسی نئودمیوم (ضخامت ۳۰۰ نانومتر)/لایه محافظ تنگستن (ضخامت ۳ نانومتر) پوشش داده شد. فشار اولیه سیستم کمتر از ۳×۱۰^{-۶} تور تنظیم شد. فشار پراکنش لایه بافر تنگستن و لایه مغناطیسی NdFeB به ترتیب ۵ و ۳×۱۰^{-۳} تور تنظیم شد. نرخ پراکنش لایه مغناطیسی و لایه بافر تنگستن ۱۷ و ۱۵ نانومتر در دقیقه انتخاب شد. به‌منظور بلوری شدن لایه مغناطیسی آنیل لایه‌های تهیه شده در محدوده دمایی ۴۵۰ تا ۶۵۰ درجه‌سانی گراد در کوره عملیات حرارتی لوله‌ای کوارتزی تحت گاز آرگون با نرخ گرمایش ۱۵ درجه‌سانی گراد در دقیقه به مدت ۳۰ دقیقه انجام شد. آزمون پراش پرتو ایکس با استفاده از پرتو CuKα برای نمونه‌ها انجام شد. از طول موج اشعه ایکس ۱/۵۴۲ آنگستروم و فیلتر نیکل استفاده شد. نرخ روبش معادل ۰/۵ درجه بر دقیقه، ولتاژ اعمالی برابر با ۳۰ کیلوولت و جریان معادل ۳۰ میلی‌آمپر انتخاب شد. ارزیابی میکروسکوپ از سطح مقطع و سطح لایه‌های نازک توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدان (FE-SEM) انجام شد. مدل میکروسکوپ الکترونی JSM-7000F, JEOL و مجهز به تحلیلگر EDS مدل JEO-۲۳۰۰ F بود. به‌منظور اندازه‌گیری زبری و نیز مشاهده توپوگرافی سطح از میکروسکوپ نیز اتمی با مدل ویکو استفاده شد و تصاویر حاصله در شرایط غیرتماسی بود. رفتار مغناطیسی لایه‌های نازک نیز به‌کمک دستگاه مغناطومتر (VSM) تعیین شد و نحوه تغییرات مغناطیش اشباع و نیروی پسمندزدا با تغییرات دما مشخص شد.



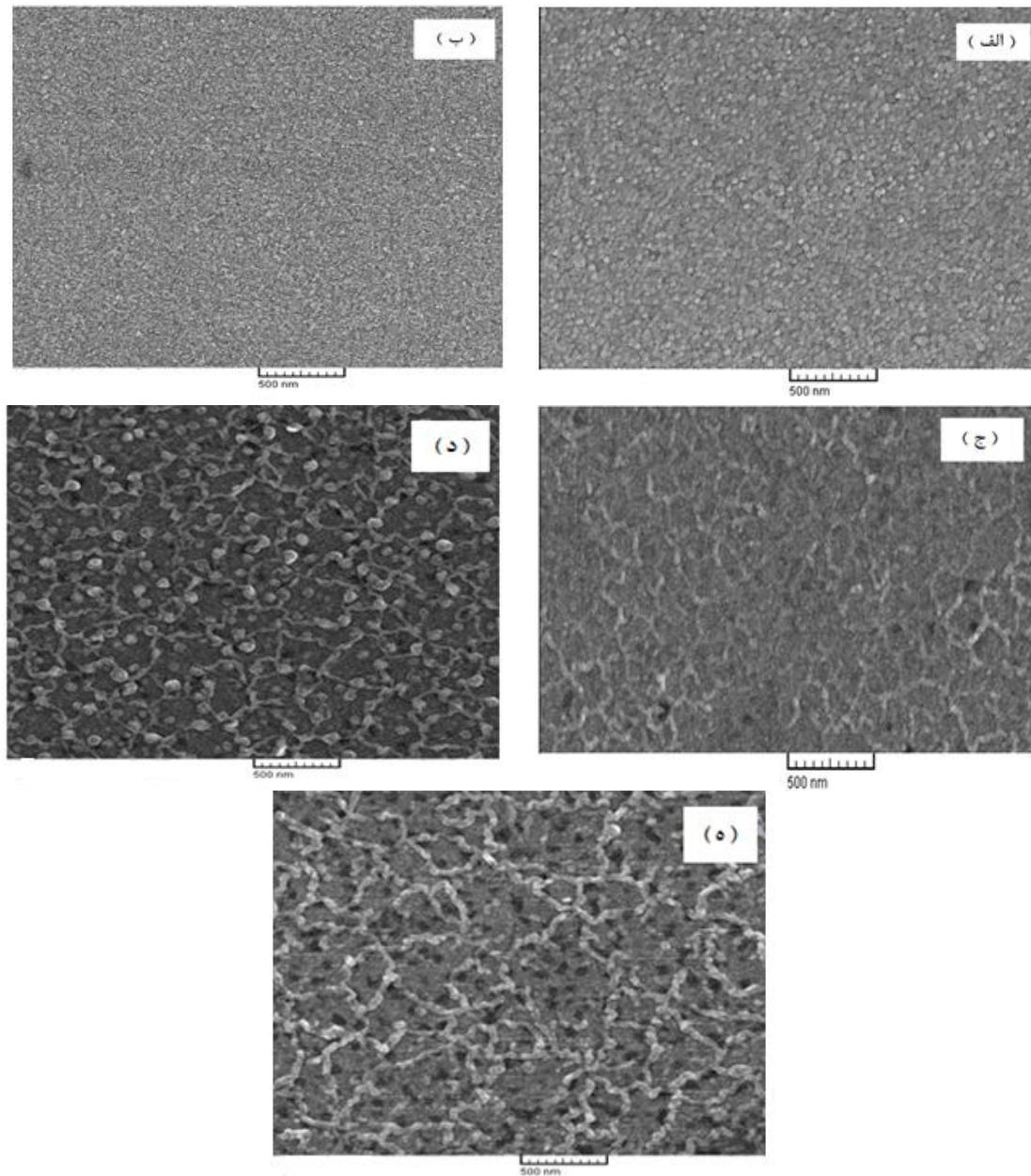
شکل ۱- ارتباط بلورشناسی شبکه بین لایه تنگستن و فاز مغناطیسی نئودمیوم آهن بور



شکل ۲- الگوهای پراش پرتو ایکس لایه‌های نازک نئودمیوم-آهن-بور آنیل شده در دمای مختلف

شرط لازم برای داشتن نیروی پسماندزدا و نسبت مربعی شدن بالا تشکیل فاز $Nd_2Fe_{14}B$ است. با مقایسه الگوهای پراش اشعه ایکس نمونه‌ها با نتایج پژوهشگران دیگر، کاملاً غیربلورین نمونه شاهد قابل ملاحظه است. در دمای 450°C درجه سانتی گراد لایه‌ها دستخوش یک استحالة ساختاری می‌شوند و از حالت غیربلورین به فاز $Nd_2Fe_{14}B$ تبدیل می‌شوند، و چیدمان در

جهت محور آسان (جهت c تتراتوکنال) قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که در روش پراکنش با امواج رادیویی شرایط پوشش‌دهی غیرتعادلی است و در صورتی که زیرلایه در حین فرایند و یا پس از فرایند تحت عملیات حرارتی قرار نگیرد، فاز بلوری تشکیل نخواهد شد و صرفاً هاله‌های شیشه‌ای فاز غیربلورین در الگوی پراش نمایان می‌شود. البته با اعمال دما در شرایط کنترل شده (خلاء) امکان بلوری شدن فاز نئودمیوم آهن بور وجود دارد. اتمسفر کوره عملیات حرارتی می‌بایست به‌دقیق کنترل شود. حضور اکسیژن در اتمسفر و اکتیویته بالای نئودمیوم در واکنش با اکسیژن امکان تشکیل اکسیدهای مختلف را امکان‌پذیر می‌سازد. با افزایش دما میزان بلورینگی فاز مغناطیسی زیاد می‌شود. این موضوع را می‌توان از افزایش شدت قله‌های پراش پرتو ایکس مشاهده کرد. گفتنی است که محاسبه درصد وزنی فاز مغناطیسی در سیستم نیاز به حضور نمونه استاندارد و استفاده از روش‌های استاندارد بیرونی یا استاندارد درونی دارد. همان‌گونه که می‌دانیم محور c محور آسان مغناطیسی در فاز $Nd_2Fe_{14}B$ تتراتوکنال است. در لایه‌های آنیل شده بیشتر از 450°C درجه سانتی گراد لایه‌ها با بافت محوری c بر جسته، (115)، (116) و (117) به‌دست می‌آید. شدت بیشینه بازتاب فاز $Nd_2Fe_{14}B$ در دمای آنیل 550°C درجه سانتی گراد به‌دست می‌آید. با افزایش بیشتر دمای آنیل شدت قله‌های فاز $Nd_2Fe_{14}B$ کاهش می‌یابد که در نتیجه بافت محوری c کاهش می‌یابد. نتایج به‌دست آمده تطبیق مناسبی با پژوهش‌های سایر



شکل ۳- تصاویر میکروسکوپی لایه‌های نازک نودمیوم-آهن-بور در دمای آنیل مختلف:
 (الف) ۴۵۰، (ب) ۴۵۰، (ج) ۵۰۰، (د) ۵۵۰ و (ه) ۶۰۰ درجه‌سانتی‌گراد

پژوهشگران دارد [۷-۱۰].
 شکل ۳ تصاویر میکروسکوپی لایه‌های آنیل شده را در
 دماهای مختلف نشان می‌دهد. تصاویر نشان می‌دهند که ریخت
 (مورفولوژی) سطحی کاملاً تحت تاثیر دمای آنیل است.
 محدوده دمای بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ درجه‌سانتی‌گراد بالاترین
 سرعت رشد دانه را در میان دماهای آنیل مختلف دارد و

تغییرات اندازه دانه در این محدوده دارای بالاترین شب است.
 قابل ملاحظه است که با افزایش دمای آنیل، میانگین اندازه دانه‌ها
 افزایش می‌یابد و در دمای ۴۵۰ درجه‌سانتی‌گراد به ۴۰ نانومتر
 می‌رسد و هنگامی که دمای آنیل به ۶۵۰ درجه‌سانتی‌گراد افزایش
 یابد، این مقدار به ۳۰۰ نانومتر خواهد رسید. در واقع افزایش
 دما باعث تغییر اندازه و ریخت دانه می‌شود. واضح است که با

از دیاد دما ضریب نفوذ عناصر افزایش می‌یابد. این موضوع باعث رشد دانه در سیستم می‌شود. از طرفی امکان نفوذ متقابل عناصر زیرلایه در لایه مغناطیسی فراهم می‌شود. با توجه به حضور لایه بافر تنگستن، نفوذ متقابل عناصر زیرلایه و لایه مغناطیسی امکان‌پذیر نخواهد بود. از آنجایی که تنگستن یک عنصر دیرگداز است، نفوذ آن به درون لایه مغناطیسی نیاز به دماهای بسیار بالا دارد که در این پژوهش انتخاب دمای عملیات حرارتی به‌گونه‌ای بود که ضمن تشکیل فاز نئومیوم آهن بور در سیستم، امکان نفوذ عناصر تنگستن وجود نداشته باشد. نکته مهم دیگری که از تصاویر میکروسکوپی الکترونی رو بشی معین است تغییر ریخت دانه‌های مغناطیسی است. دانه‌ها در دماهای پایین (کمتر از ۵۰۰ درجه‌سانتی‌گراد) دارای رشد ناهمسان‌گرد تتراگونال هستند. افزایش دما باعث می‌شود که علاوه بر رشد عمودی، رشد صفحه‌ای نیز انجام شود و در نتیجه ناهمسان‌گردی مغناطوبلوری کاهش یابد. این موضوع به خصوص در دمای ۶۵۰ درجه‌سانتی‌گراد به‌خوبی مشخص است که سیستم شامل دو نوع دانه‌بندی است. نوع اول دانه‌ها با رشد عمودی که باعث ایجاد ناهمسان‌گردی مغناطوبلوری بالا می‌شوند و نوع دوم دانه‌های جانی که مانع ارتقاء ناهمسان‌گردی بلوری می‌شوند. با توجه به اینکه اندازه دانه‌ها از حد سوپرپارامغناطیس برای نئومیوم آهن بور بسیار بزرگ‌تر است، لذا انتظار رفتار فرومغناطیس در سیستم می‌رود که این موضوع از منحنی‌های پسماند نتیجه گرفته شد.

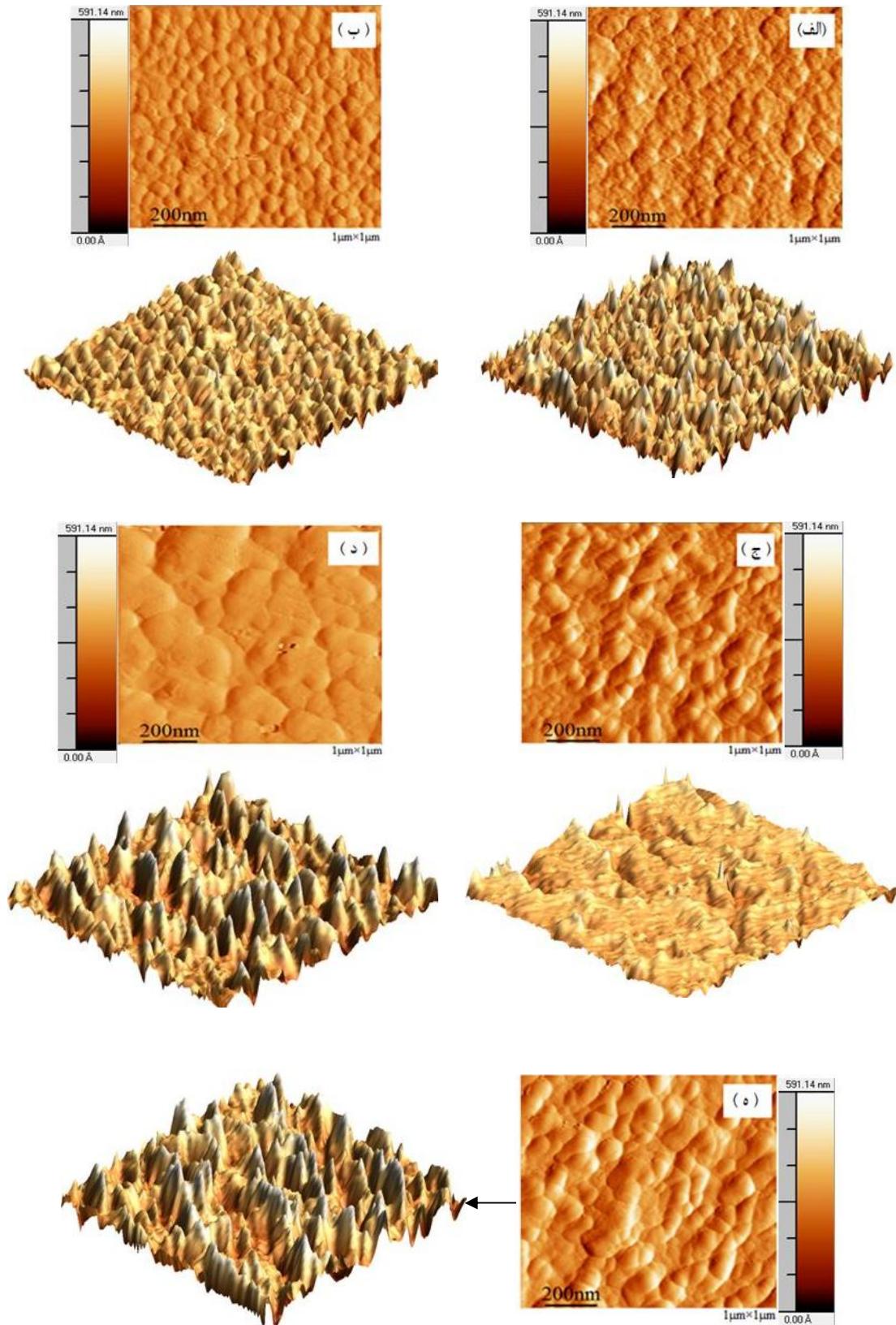
توپوگرافی لایه‌های نازک که توسط میکروسکوپ نیروی اتمی تهیه شده، در شکل ۴ نشان داده شده است. این شکل نشان می‌دهد که سطح لایه‌ها عاری از هرگونه ترک و تخلخل است. تصاویر میکروسکوپی نیروی اتمی در شرایط دوبعدی و سه‌بعدی تهیه شده است. روشن است که با افزایش دما و ازدیاد ضریب نفوذ و رشد چندجانبه دانه‌ها، میزان زبری سطح افزایش می‌یابد. جدول ۱ روند افزایش میزان زبری متوسط را با دما مشخص می‌کند. لازم به ذکر است که میزان زبری می‌تواند بر نیروی پسماندزدا و میدان جوانه‌زنی تأثیرگذار باشد. هرچقدر

جدول ۱- زبری سطح لایه نازک نئومیوم آهن بور در دماهای مختلف عملیات حرارتی

R _a (nm)	R _y (nm)	R _z (nm)	R _{ms} (nm)	R _p (nm)	R _v (nm)	دما (°C)
۳	۳۶	۱۷	۴	۲۱	۱۴	۴۵۰
۳	۳۸	۱۸	۴	۲۳	۱۴	۵۰۰
۳	۴۵	۲۲	۴	۲۸	۱۶	۵۵۰
۴	۴۹	۲۴	۵	۳۲	۱۶	۶۰۰
۳	۵۲	۲۵	۴	۳۴	۱۸	۶۵۰

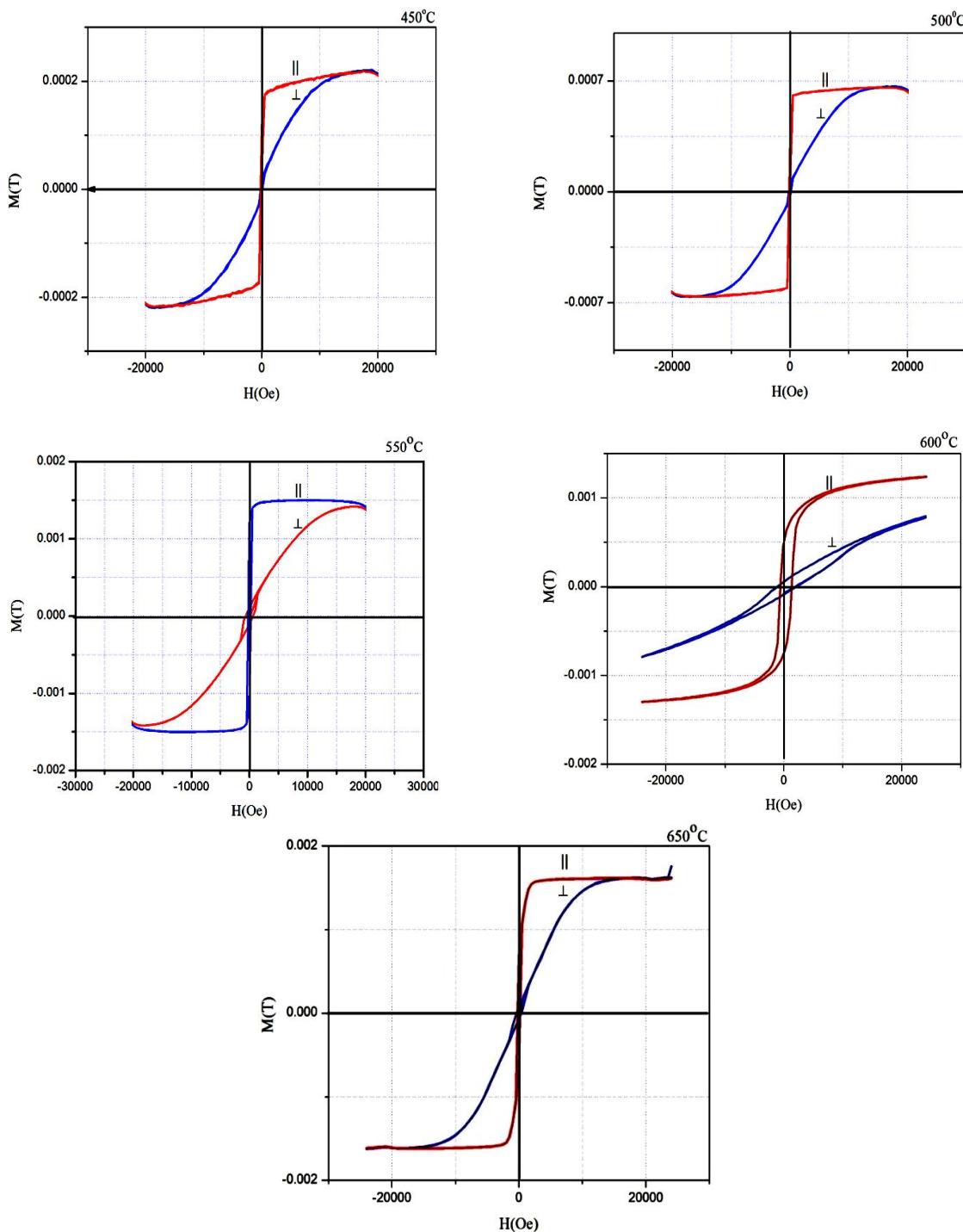
میزان زبری سطح افزایش یابد، مکان‌های میخ‌کوب در دانه‌ها زیادتر می‌شوند و در نتیجه حرکت دیواره حوزه‌های مغناطیسی و چرخش غیرکوهیرنت بردار مغناطش سخت‌تر می‌شود. این موضوع باعث افزایش نیروی پسماندزدا می‌شود. نیروی پسماندزدا بالاتر به پایداری بیشتر بردار مغناطش با گذشت زمان و ثابت بودن چگالی اطلاعات ذخیره شده در طولانی مدت ارتباط دارد. همچنین زبری سطح بالاتر باعث می‌شود که توزیع میدان سوئیچینگ گستردگر شود و البته این موضوع در تقابل با افزایش نیروی پسماندزدا است و لذا می‌بایست تعادلی مناسب بین افزایش نیروی پسماندزدا و توزیع میدان سوئیچینگ ایجاد شود.

شکل ۵ منحنی‌های پسماند نمونه‌های آنیل شده را در دماهای مختلف نشان می‌دهد. تغییرات خواص مغناطیسی منحنی پسماند عمود و موازی لایه‌های آنیل شده در دماهای مختلف در جدول ۲ خلاصه شده‌اند. لایه‌های آنیل شده در دمای پایین‌تر از ۴۵۰ درجه‌سانتی‌گراد دارای خواص مغناطیسی نرم هستند و تفاوت زیادی در مقدار نیروی پسماندزدا در موازی و عمود بر میدان مشاهده نمی‌شود. نیروی پسماندزدا در نمونه‌های آنیل شده در دمای کمتر از ۴۵۰ درجه‌سانتی‌گراد به‌دلیل ناکافی بودن عملیات حرارتی برای بلوری شدن فاز Nd₂Fe₁₄B، کوچک است. مغناطش اشباع تابع تعداد اسپین‌های هم‌جهت شده در واحد حجم است و چون این میزان در جهات



شکل ۴- تصاویر میکروسکوپی روبشی لایه‌های نازک نیودمیوم آهن بور در دمای آنیل مختلف:

(الف) ۴۵°، (ب) ۵۰°، (ج) ۵۵°، (د) ۶۰۰ و (ه) ۶۵۰ درجه سانتی گراد



شکل ۵- منحنی پسمند لایه‌های نازک نیودمیوم-آهن-بور آنیل شده در دماهای مختلف

با توجه به عدم تشکیل فاز بلوری نیودمیوم آهن بور (مطابق با الگوی پراش پرتو ایکس) حضور فازهای نرم مغناطیسی مانند آهن باعث ایجاد چنین رفتار پسمندی می‌شود. با افزایش دما به 55°C درجه سانتی گراد، مجدداً رفتار منحنی پسمند یک رفتار

عمودی و موازی یکسان است، لذا انتظار می‌رود که مغناطش اشباع موازی و عمودی برابر باشند. میزان نیروی پسمند زدا و مغناطش باقیمانده در این دما نزدیک به صفر است که نشان‌دهنده نامناسب بودن دمای عملیات حرارتی است. احتمالاً

جدول ۲- میزان متغیرهای مغناطیسی لایه‌های نئودمیوم-آهن-بور آنیل شده در دماهای مختلف

دماهای آنیل	۴۵۰°C	۵۰۰°C	۵۵۰°C	۶۰۰°C	۶۵۰°C
$H_{c\perp}(\text{koe})$	۲/۰	۰/۳	۱	۲	۱
$H_{c\parallel}(\text{koe})$	۲/۰	۰/۳	۰/۴	۵/۰	۰/۳
$M_{s\perp}(T)$	۵۹/۰	۶/۰	۶۴/۰	۶۸/۰	۸۲/۰
$M_{s\parallel}(T)$	۵۹/۰	۶/۰	۵۵/۰	۶۸/۰	۴۱/۰
$S=(M_r/M_s)$	۱۲/۰	۱۲/۰	۱۲/۰	۱/۰	۲۶/۰

هستند. این موضوع در نتایج سایر پژوهشگران نیز مشاهده شده است [۷، ۸]. با توجه به افزایش نیروی پسماندزدا و ناهمسان‌گردی مغناطوبلوری لایه نازک، می‌توان احتمال داد که این لایه برای کاربردهای حافظه مغناطیسی مناسب است. افزایش بیشتر دما به ۶۵۰ درجه‌سانتی‌گراد باعث کاهش نیروی پسماندزدا شده است. در واقع عوامل مؤثر بر نیروی پسماندزدا اندازه دانه و ثابت ناهمسان‌گردی است. این متغیر با ثابت ناهمسان‌گردی رابطه مستقیم و با اندازه دانه رابطه معکوس دارد. با توجه به افزایش اندازه دانه با زیاد شدن دما می‌توان انتظار داشت که میزان ناهمسان‌گردی تکمحوری سیستم کاسته شده، باعث شود که مغناطش اشباع در دو حالت موازی و عمودی یکسان شوند. به عنوان جمع‌بندی و با مقایسه نتایج حاصل شده می‌توان دمای ۶۰۰ درجه‌سانتی‌گراد را به عنوان دمای بهینه برای عملیات حرارتی لایه نازک نئودمیوم آهن بور بر لایه بافر تنگستن اعلام نمود. در این دما میزان بهینه‌ای از رشد دانه، زبری سطح، بلورینگی فاز نئودمیوم آهن بور، مقدار نیروی پسماندزدا و مغناطش اشباع حاصل می‌شود که برای استفاده در سیستم‌های حافظه مغناطیسی می‌تواند به عنوان یک کاندید عمل کند.

۴- نتیجه‌گیری

- تنگستن به دلیل تطابق بلوری مناسب با نئودمیوم آهن بور به عنوان لایه بافر می‌تواند مفید باشد.

نرم مغناطیسی است. هرچند از این دما فرایند بلوری شدن نئودمیوم آهن بور آغاز می‌شود، لکن کامل شدن آن نیاز به دماهای بالاتری دارد. در این منحنی نیز مغناطش اشباع موازی و عمودی در میدان‌های کم با یکدیگر برابر هستند. افزایش دما به ۵۵ درجه‌سانتی‌گراد باعث زیاد شدن نیروی پسماندزدا عمودی به میزان تقریباً ۱۰۰۰ Oe شد. میزان نیروی پسماندزدا موازی از عمودی بسیار کمتر است و مشخص است که ناهمسان‌گردی تکمحوره در حال شکل‌گیری است. این موضوع را می‌توان با مقایسه الگوهای پراش پرتو ایکس نیز متوجه شد. در این دما نیز مغناطش اشباع موازی و عمودی با یکدیگر برابرند.

با عملیات حرارتی لایه‌های نازک در دمای ۶۰۰ درجه‌سانتی‌گراد منحنی‌های موازی و عمودی دارای پسماند بیشتری شدن، به گونه‌ای که نیروی پسماندزدا عمودی به بیش از ۲۰۰۰ Oe افزایش یافت. مشاهده می‌شود که مغناطش اشباع موازی و عمودی یکسان نیستند و این موضوع با نظریه‌های موجود تطابق ندارد. دلیل این موضوع به اشباع نرسیدن منحنی پسماند در حالت عمودی است. در واقع در دمای ۶۰۰ درجه‌سانتی‌گراد ثابت ناهمسان‌گردی تکمحوری به اندازه‌ای زیاد شده است که برای رسیدن به حالت اشباع نیاز به میدان‌های اعمالی بیش از ۲۴kOe است. در صورتی که میدان‌های بالاتری اعمال شود و لایه نازک نئودمیوم آهن بور به اشباع برسد، آنگاه مغناطش اشباع در دو حالت با یکدیگر برابر

- میزان زبری سطح لایه نازک مغناطیسی با افزایش دما زیاد می شود و در 650°C درجه سانتی گراد به مقدار بیشینه خود می رسد.
- در دمای 650°C درجه سانتی گراد ، میزان بیشینه نیروی پسماند زدا عمودی تشکیل می شود و ثابت ناهمسان گردی مغناطیسی بلوری زیاد می شود. این دما به عنوان دمای بهینه برای عملیات حرارتی لایه نازک نئودمیوم آهن بور بر لایه با فر تنگستن معرفی می شود.
- با افزایش دمای عملیات حرارتی از 400°C به 450°C درجه سانتی گراد فاز بلوری نئودمیوم آهن بور شروع به جوانهزنی و رشد می کند و در دمای 600°C درجه سانتی گراد به بلورینگی مناسب برای کاربرد حافظه مغناطیسی می رسد.
- با افزایش دما رشد تک محوری نئودمیوم آهن بور به رشد جانبی تبدیل می شود و دمای این استحاله حدود 550°C درجه سانتی گراد است

مراجع

1. Sagawa, M., Togawa, N., Yamamoto, H. and Matsuura, Y., "New Material for Permanent Magnets on a Base of Nd and Fe (Invited)", *Journal of Applied Physics*, Vol. 55, pp. 2083-2087, 1984.
2. Velu, E.M.T. and Lambeth, D.N., "High Density Recording on SmCo/Cr Thin Film Media", *IEEE Transactions on Magnetics*, Vol. 28, pp. 3249 - 3254, 1992.
3. Weller, D., Moser, A., Folks, L., Best, M., Lee, W., Toney, M., Schwickert, M., Thiele, J. and Doerner, M., "High Ku Materials Approach to 100 Gbits/in²", *IEEE Transactions on Magnetics*, Vol. 36, pp. 10-15, 2000.
4. Sagawa, M., Fujimura, S., Yamamoto, H., Matsuura, Y. and Hirosawa, S., "Magnetic Properties of rare-Earth-Iron-Boron Permanent Magnet Materials", *Journal of Applied Physics*, Vol. 57, pp. 4094-4098, 1985.
5. Kronmuller, H., Durst, K.D. and Sagawa, M., "Analysis of the Magnetic Hardening Mechanism in RE-FeB Permanent Magnets", *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, Vol. 74, pp. 291-302, 1988.
6. Hirosawa, S., Matsuura, Y., Yamamoto, H., Fujimura, S., Sagawa, M. and Yamauchi, H., "Magnetization and Magnetic Anisotropy of R2Fe14B Measured on Single Crystals", *Journal of Applied Physics*, Vol. 59, pp. 873-8777, 1986.
7. Liu, X., Shiozaki, Y. and Morisako, A., "Magnetization Reversal Mechanism of Ultra Thin Nd₂Fe₁₄B Films with Perpendicular Magnetic Anisotropy", *Journal of Applied Physics*, Vol. 103, pp. 103-107, 2008.
8. Yu, M., Liu, Y., Liou, S.H. and Sellmyer, D.J., "Nanostructured NdFeB Films Processed by Rapid Thermal Annealing", *Journal of Applied Physics*, Vol. 83, pp. 6611-6613, 1998.
9. Kim, M.J., Li, Y., Kim, Y.B., Ryu, K.S., Song, C.B., Kim, C.O. and Kim, T.K., "Structural and Intrinsic Magnetic Properties of Y₃(Fe_{0.96}Ti_{0.04})₂₉ and its Nitride", *IEEE Transactions on magnetics*, Vol. 36, pp. 3339-3341, 2000.
10. Neu, V., Melcher, S., Hannemann, U., Fahler, S. and Schultz, L., "Growth, Microstructure, and Magnetic Properties of Highly Textured and Highly Coercive Nd-Fe-B Films", *Physical Review*, Vol. 70, pp. 144418-144422, 2004.
11. Suzuki, S., Hatayama, Y., Iwama, H. and Shima, T., "Effect of Heat Treatment on the Magnetic Properties for Nd-Fe-B/Nd-Cu Multilayer Films", *IEEE Transactions on Magnetics*, Vol. 47, pp. 2796-2799, 2011.
12. Serrona, L.K.E.B., Sugimura, A., Fujisaki, R., Okuda, T., Adachi, N., Ohsato, H., Sakamoto, I., Nakanishi, A. and Motokawa, M., "Magnetic and Structural Properties of NdFeB Thin Film Prepared by Step Annealing", *Materials Science and Engineering*, Vol. B97, pp. 59-63, 2003.
13. Serrona, L.K.E.B., Fujisaki, R., Sugimura, A., Okuda, T., Adachi, N., Ohsato, H., Sakamoto, I., Nakanishi, A., Motokawa, M., Ping, D.H. and Hono, K., "Enhanced Magnetic Properties of Nd-Fe-B Thin Films Crystallized by Heat Treatment", *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, Vol. 260, pp. 406-414, 2003.
14. Speliotis, T., Niarchos, D., Skumryev, V., Zhang, Y. and Hadjipanayis, G., "Effect of Post Deposition Annealing on the Hysteresis Loops of Sputtered NdFeB Films", *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, Vol. 272-276, pp. 877-879, 2004.
15. Constantinescu, C., Patroiu, E., Codescu, M. and Dinescu, M., "Effect of Nitrogen Environment on NdFeB Thin Films Grown by Radio Frequency Plasma Beam Assisted Pulsed Laser Deposition", *Materials Science and Engineering*, Vol. B178, pp. 267-271, 2013.

16. Lei, T., Heqin L., Jiong, S., Kai, Q., Wei, W., Chu, Z., Jing, Z. and Qiong, T., "Corrosion Resistance of the NdFeB Coated with AlN/SiC Bilayer Thin Films by Magnetron Sputtering under Different Environments", *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, Vol. 375, pp. 124-128, 2011.
17. Fujiwara, R., Shinshi, T. and Kazawa, E., "Micromagnetization Patterning of Sputtered NdFeB/Ta Multilayered Films Utilizing Laser Assisted Heating", *Sensors and Actuators A: Physical*, Vol. 220, pp. 298-304, 2014.
18. Constantinescu, C., Ion, V., Codescu, M., Rotaru, P. and Dinescu, M., "Optical, Morphological and Thermal Behaviour of NdFeB Magnetic Thin Films Grown by Radiofrequency Plasma-Assisted Pulsed Laser Deposition", *Current Applied Physics*, Vol. 13, pp. 2019–2025, 2013.